

1SV223

シリコンエピタキシャルプレーナ形バリキャップダイオード Silicon Epitaxial Planar Variable Capacitance Diodes

● 特長

- 1) 小型面実装タイプである (DSM)。
- 2) 高信頼である。

● Features

- 1) Small surface mount type (DSM).
- 2) High reliability.

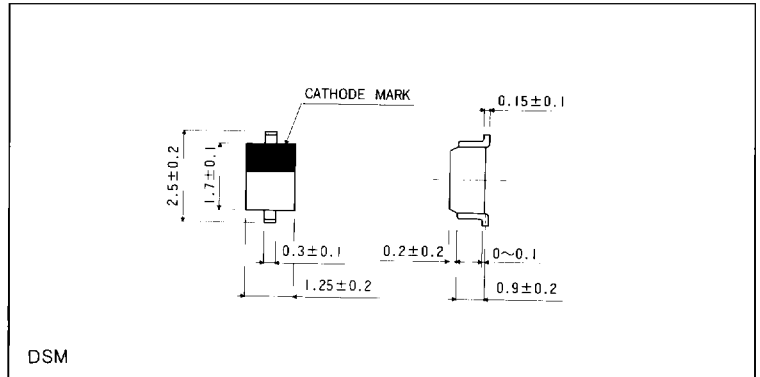
● 用途

同調用

● Applications

Tunning.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
せん頭逆方向電圧	V_{RM}	35	V
直流逆方向電圧	V_R	30	V
接合部温度	T_j	120	°C
保存温度	T_{stg}	-30~+120	°C

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	—	0.01	10	nA	$V_R = 28V$
端子間容量 1	C_{t1}	13.88	—	16.04	pF	$V_R = 2V, f = 1MHz$
端子間容量 2	C_{t2}	2.015	—	2.385	pF	$V_R = 25V, f = 1MHz$
直列抵抗	R_S	—	0.45	0.6	Ω	$C_t = 14pF, f = 470MHz$

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves (Ta=25°C)

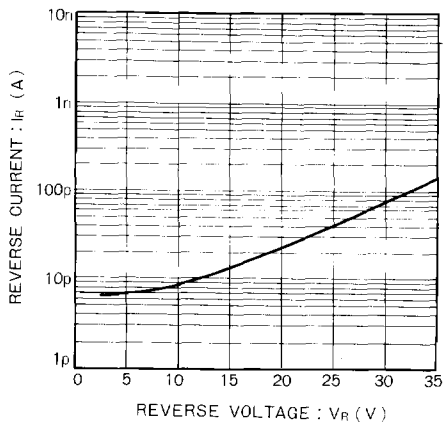


Fig.1 逆方向温度特性

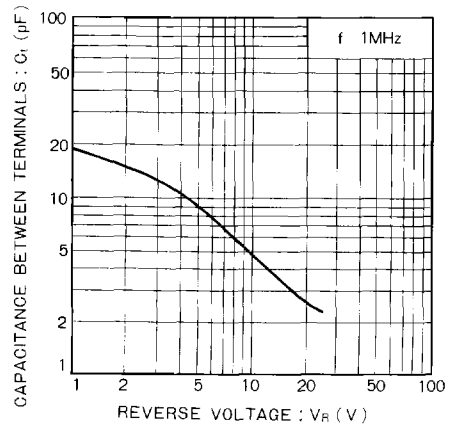


Fig.2 端子間容量特性

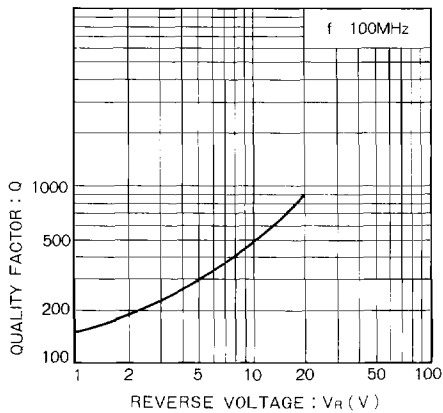


Fig.3 容量指数特性

バリキャップダイオード
同調用ダイオード